

XVI Международная конференция "Термоэлектрики и их применения --- 2018" (ISCTA 2018), Санкт-Петербург, 8- 12 октября 2018 г. Дашевский З.М., Константинов П.П., Скипидаров С.Я.	
XVI Международная конференция "Термоэлектрики и их применения --- 2018" (ISCTA 2018), Санкт-Петербург, 8-12 октября 2018 г. Новое направление применения термоэлектрических преобразователей энергии	875
Ашим Е.Ж., Инербаев Т.М., Акилбеков А.Т., Miki H., Takagi T., Ховайло В.В. Теоретическое моделирование термоэлектрических свойств сплавов Гейслера $Fe_2Ti_{1-x}V_xSn$	879
Кадирова Д.К. Термоэлектрический интенсификатор теплопередачи между двумя движущимися средами с различной температурой	883
Публикация материалов Конференции завершена.	
Электронные свойства полупроводников Казанин М.М., Каминский В.В., Гревцев М.А. Эффект Пула-Френкеля в поликристаллическом сульфиде европия	887
Прокофьева Л.В., Константинов П.П. О структуре энергетического спектра дырок в материалах A^IVB^VI под иным углом зрения	890
Юрасов Д.В., Байдакова Н.А., Дроздов М.Н., Морозова Е.Е., Калинин М.А., Новиков А.В. Влияние отжига на свойства слоев $Ge : Sb/Si(001)$ с концентрацией сурьмы выше уровня ее равновесной растворимости в германии	897
Поверхность, границы раздела, тонкие пленки Алфимова Д.Л., Лунин Л.С., Лунина М.Л., Пащенко А.С., Данилина Э.М. Изопараметрические гетероструктуры $AlInGaAsP/InP$ и их свойства	903
Лебедев М.В., Львова Т.В., Шахмин А.Л., Рахимова О.В., Дементьев П.А., Седова И.В. Эволюция физико-химических свойств поверхности $GaSb(100)$ в растворах сульфида аммония	908
Медведев А.В., Дукин А.А., Феоктистов Н.А., Голубев В.Г. Сферический распределенный брэгговский отражатель со всенаправленной стоп-зоной в ближней ИК-области спектра	917
Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления Гусейнов Р.Р., Танрывердиев В.А., Belenky G.L., Kipshidze G., Алиева Е.Н., Алигулиева Х.В., Ализаде Э.Г., Ахмедова Х.Н., Абдуллаев Н.А., Мамедов Н.Т., Зверев В.Н. Электрические и оптические свойства нерелаксированных гетерозпитаксиальных структур $InAs_{1-x}Sb_x$	922
Бадикова П.В., Глазов С.Ю., Сыродоев Г.А. Особенности ионизации примесей в квазиклассически сильных постоянном и переменном электрических полях в двумерной сверхрешетке на основе графена	927
Подгорных С.М., Якунин М.В., Криштопенко С.С., Попов М.Р., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А. Температурная активация электронов проводимости в двойной квантовой яме $HgTe/CdHgTe$ р-типа проводимости со слоями $HgTe$ критической толщины	935
Домашевская Э.П., Голощапов Д.Л., Хасан Исмаил Дамбос Аль Хайлани, Руднев Е.В., Гречкина М.В., Рябцев С.В. Особенности морфологии и оптических свойств наноструктур дисульфида молибдена от мономолекулярного слоя до фракталообразной субструктуры	940
Васильева Г.Ю., Грешнов А.А., Васильев Ю.Б., Михайлов Н.Н., Усикова А.А., Haug R.J. Магнетотранспортная спектроскопия интерфейсных, квантово-ямных и гибридных состояний в структурах с многочисленными слоями $HgTe$ толщиной 16 нм	947
Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники Гусева Е.А., Форш Е.А. Зависимость проводимости слоев пористого кремния от направления переноса носителей заряда	953

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники	
Садовников С.И., Ремпель А.А. Ориентационные соотношения при структурном превращении моноклинной и кубической фаз в сульфиде серебра	958
Талызин И.В., Самсонов М.В., Самсонов В.М., Пушкарь М.Ю., Дронников В.В. Размерная зависимость температуры плавления наночастиц кремния: молекулярно-динамическое и термодинамическое моделирование	964
Углеродные системы	
Давыдов С.Ю. Эпитаксиальный карбин: аналитические результаты	971
Физика полупроводниковых приборов	
Кюрегян А.С. Высоковольтные диффузионные диоды с резким восстановлением. I. Численное моделирование	978
Кюрегян А.С. Высоковольтные диффузионные диоды с резким восстановлением. II. Теория	985
Корольков О.М., Козловский В.В., Лебедев А.А., Слепчук Н., Тоомпиу J., Rang T. Низкотемпературный отжиг слаболегированных слоев n-4H-SiC после облучения быстрыми электронами	991
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Орлов Л.К., Ивина Н.Л., Боженкин В.А. Особенности начальной стадии гетероэпитаксии слоев кремния на германии при их выращивании из гидридов кремния	995
Бессолов В.Н., Коненкова Е.В., Орлова Т.А., Родин С.Н., Середова Н.В., Соломников А.В., Щеглов М.П., Кибалов Д.С., Смирнов В.К. Свойства полуполярного GaN, выращенного на подложке Si(100)	1006
Середин П.В., Леньшин А.С., Золотухин Д.С., Голощапов Д.Л., Мизеров А.М., Арсентьев И.Н., Бельтюков А.Н. Исследование влияния переходного слоя нанопористого кремния на атомное и электронное строение, а также оптические свойства гетероструктур A^mN/pog-Si, выращенных методом плазменно-активированной молекулярно-пучковой эпитаксии	1010